



Nota de prensa

KIOXIA comienza los envíos de muestras de dispositivos TLC BiCS FLASH™ de 512 Gb de 9ª generación

Combina las tecnologías CMOS avanzadas y de celdas de memoria existentes para maximizar la eficiencia de la inversión

Düsseldorf, Alemania, 25 de julio de 2025: [KIOXIA Europe GmbH](#), líder mundial en soluciones de memoria, ha anunciado hoy que ha comenzado los envíos de muestras¹ de dispositivos de memoria de celda de triple nivel (TLC) de 512 Gb que incorporan su tecnología de memoria flash 3D BiCS FLASH™ de 9ª generación. Planea comenzar la producción en masa en el año fiscal 2025. Los dispositivos están diseñados para admitir aplicaciones que requieren un alto rendimiento y una eficiencia energética excepcional en las capacidades de almacenamiento de nivel bajo a medio. También se integrarán en las SSD empresariales de KIOXIA, en particular aquellas que tienen como objetivo maximizar la eficiencia de la GPU en los sistemas de IA.

KIOXIA continúa persiguiendo una estrategia de doble eje para abordar las diversas necesidades de las aplicaciones de vanguardia, al tiempo que ofrece productos competitivos que brindan una eficiencia de inversión óptima. Los dos ejes son:

- Productos BiCS FLASH™ de 9ª generación: logran un alto rendimiento a un costo de producción reducido al aprovechar la tecnología CBA (CMOS directamente unida a la matriz)², que integra las tecnologías de celdas de memoria existentes³ con la última tecnología CMOS.
- Productos BiCS FLASH™ de 10ª generación: incorporan una expansión en el número de capas de memoria para satisfacer la demanda futura esperada de soluciones de mayor capacidad y alto rendimiento.

La nueva BiCS FLASH™ 512Gb TLC de 9ª generación, desarrollada mediante un proceso de apilamiento de 120 capas basado en la tecnología BiCS FLASH™ de 5ª generación y la tecnología CMOS avanzada, presenta mejoras significativas en el rendimiento con respecto a los productos BiCS FLASH™⁴ existentes de KIOXIA con la misma capacidad de 512 Gb. Estas incluyen:

- Rendimiento de escritura: Mejora del 61 %
- Rendimiento de escritura: Mejora del 12 %

KIOXIA

- Eficiencia energética: mejorada en un 36 % durante las operaciones de escritura y un 27 % durante las operaciones de lectura
- Velocidad de transferencia de datos: la interfaz Toggle DDR6.0 permite un rendimiento de interfaz NAND de alta velocidad de 3,6 Gb/s⁵
- Densidad de bits: aumentada en un 8 % a través de los avances en el escalado planar

Además, KIOXIA ha confirmado que la TLC de 512 Gb funciona a velocidades de interfaz NAND de hasta 4,8 Gb/s⁵ en condiciones de demostración. La línea de productos se determinará de acuerdo con las demandas del mercado.

"Las ventajas de TLC de mayor densidad de almacenamiento, rentabilidad y rendimiento ofrecidas a través de la memoria flash 3D BiCS FLASH™ de 9ª generación de KIOXIA serán muy adecuadas para dispositivos del Internet de las Cosas y sistemas integrados en el sector industrial y de automoción, donde el coste y la capacidad son lo más importante. También proporcionará almacenamiento asequible y de alta capacidad a través de servicios de almacenamiento en la nube y tareas de lectura intensiva como las que se ven en IA y aprendizaje automático", añade Axel Störmann, vicepresidente y director de tecnología de productos de memoria y SSD de KIOXIA Europe GmbH.

KIOXIA se compromete a fortalecer sus asociaciones globales y a seguir innovando para seguir ofreciendo soluciones óptimas que satisfagan las diversas necesidades de sus clientes.

###

Notas:

1. Estas muestras son para el propósito de verificación funcional y las especificaciones de las muestras pueden diferir en la producción en masa.
2. Tecnología en la que cada oblea CMOS y oblea de matriz de celdas se fabrican por separado en su estado optimizado y luego se unen.
3. Una BiCS FLASH™ de 5ª generación de 112 capas y una BiCS FLASH™ de 8ª generación de 218 capas. La nueva línea de productos BiCS FLASH™ de 9ª generación incorporará una de estas, según el modelo.
4. BiCS FLASH™ de 6ª generación, que está implementando la misma TLC de 512 Gb que este producto.
5. 1 Gbps se calcula como 1 000 000 000 bits/segundo. Este valor se obtiene en un entorno de prueba específico y puede variar según las condiciones de uso.

*En cada mención de un producto KIOXIA: La densidad del producto se identifica en función de la densidad de los chips de memoria dentro del producto, no de la cantidad de capacidad de memoria disponible para el almacenamiento de datos por parte del usuario final. La capacidad utilizable por el consumidor será menor debido a las áreas de datos de sobrecarga, el formato, los bloques defectuosos y otras restricciones, y también puede variar según el dispositivo host y



la aplicación. Para obtener más información, consulte las especificaciones del producto aplicable. La definición de 1 Gb = 2^{30} bits = 1 073 741 824 bits.

* Las velocidades de lectura y escritura son los mejores valores obtenidos en un entorno de prueba específico en KIOXIA, y KIOXIA no garantiza velocidades de lectura ni de escritura en dispositivos individuales. La velocidad de lectura y escritura puede variar según el dispositivo utilizado y el tamaño del archivo leído o escrito.

*Los nombres de empresas, nombres de productos y nombres de servicios pueden ser marcas comerciales de empresas de terceros.

Acerca de KIOXIA

KIOXIA es líder mundial en soluciones de memoria y se dedica al desarrollo, la producción y la venta de memorias Flash y unidades de estado sólido (SSD). Su empresa predecesora, Toshiba Memory, se separó en abril de 2017 de Toshiba Corporation, la empresa que inventó la memoria Flash NAND en 1987. El compromiso de KIOXIA es mejorar el mundo con «memoria» ofreciendo productos, servicios y sistemas que representen opciones para los clientes y un valor añadido para la sociedad basado en la memoria. La innovadora tecnología de memoria Flash 3D de KIOXIA, BiCS FLASH™, está dando forma al futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, como los teléfonos inteligentes avanzados, ordenadores, unidades SSD, sistemas de la automoción, centros de datos y sistemas de IA generativa.

Visite el [sitio web de KIOXIA](#)

Datos de contacto para la publicación:

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Alemania

Tel.: +49 (0)211 368 77-0

Correo electrónico: KIE-support@kioxia.com

Datos de contacto para consultas editoriales:

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tel.: +49 (0) 211 36877 382

Correo electrónico: [lena1.hoffmann@kioxia.com](mailto:lana1.hoffmann@kioxia.com)

Publicado por:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +49 (0)4181 968098-13

Correo electrónico: birgit.schoeniger@publitek.com

Sitio web: www.publitek.com